

(14) Si_2O ガスによる鉄中への Si の吸収について(Si_2O_2 還元と鉄中への Si の吸収に関する研究 - I)

東京工業大学

○板谷 宏

後藤和弘 梁野 檜

東京大学の館充、金鉄祐両氏は Si_2O gas により鉄中に Si を入れることを報告した。⁽¹⁾(1) 研究目的：製錬過程における Si_2O_2 の還元機構と鉄表面にみる反応機構および吸収反応機構を明らかにすることを目的とする。本報では Si_2O ガスの役割を定性的に実験解明することを目的とする。

(2) 実験方法：第1図に実験装置の概略を示す。

$\text{Fe}-\text{C}$ 合金約 50 gr を Al_2O_3 ルツボに溶解し $1350^\circ\text{C} \sim 1550^\circ\text{C}$ の所定の実験温度に保持した。一方溶鉄の上方に Si_2O_2 粒子と黒鉛粒の混合層をあし、COガスを通し、 Si_2O_2 を Si_2O gas に還元し、 $\text{CO}-\text{CO}_2-\text{Si}_2\text{O}$ 混合ガスを溶鉄表面に吹きつけた。保持時間は変えて鉄中の Si を X-ray micro-analyser にて測定した。溶鉄の温度と混合層の温度は 2 本の PR 熱電対を用いて測定した。同様の実験を固体鉄についても行った。固体鉄の場合の温度分布は $800^\circ\text{C} \sim 1450^\circ\text{C}$ である。

(3) 実験結果：第2図に溶鉄中の Si と C の時間による変化を 1360°C と 1500°C について示す。溶鉄の場合は Si が増加する一方 C は減少する傾向があることが分かった。又温度が高くなるほど Si と C の変化が速くなることも分かる。固体鉄の場合は適当に切断し、 Si_2O ガスと接触させて表面を 2 回かせて樹脂に埋め、アナライザで断面について Si の定量分析をした。その結果炭素の含有しない固体鉄の場合は Si が内部に入らず、表面に数ミクロンの Si-rich 層 (Fe を含有せず) が生成することがわかった。表面層の定量分析には問題があったが、場所によって数 % Si から数十 % Si が検出された。

(4) 考察：溶鉄の場合、鉄表面で次の反応が同時に起きると考えられる。

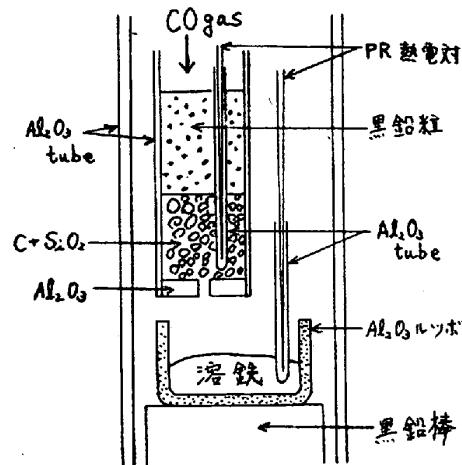
$$\text{Si}_2\text{O}(g) + \text{C} = \text{Si} + \text{CO}, \quad \text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}.$$

但しこの两者の反応の割合は吹きつけた $\text{CO}-\text{CO}_2-\text{Si}_2\text{O}$ 混合ガスの組成が不明なのであからざり。一方炭素を含有しない溶鉄と固体鉄の場合は Si が内部に入らず、これは鉄中の O と disproportionation で生成した Si とが表面で反応して Si_2O_2 の膜を生成したためではないかと考えられる。

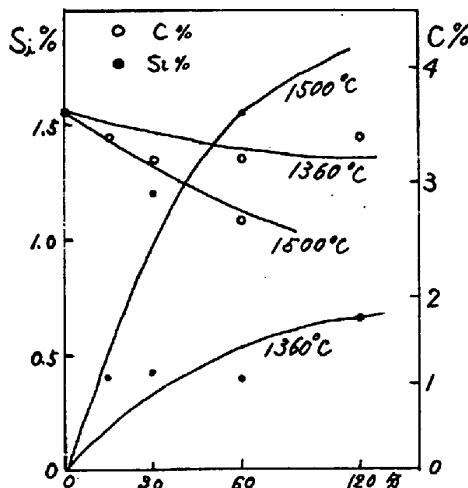
以上により鉄中に Si が吸収されるには Si_2O ガスが大きな役割をし、更に鉄中に O が少いことが必要条件のように考えられる。

終りに実験遂行に協力した東京工業大学学生、横山靖君に感謝する。

(1) 館 充、金鉄祐：日本学術振興会第 54 委員会(反応小委) 資料(1967年2月)



第1図 実験装置略図



第2図 溶鉄中の C と Si の変化